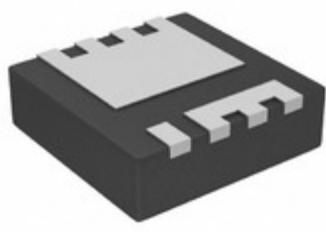



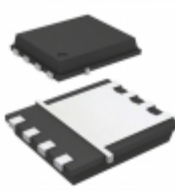






	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ018NE2LSIATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 22A TSDSON-8</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ018NE2LSIATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ018NE2LSIATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 22A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSZ018NE2LSI
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 22A (Ta), 40A (Tc) 2.1W (Ta), 69W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta), 40A (Tc)

BSZ018NE2LSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ018NE2LSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ018NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ018NE2LSIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ018NE2LSATMA1 INFINEON INFINEON PG-TSDS</p>	 <p>BSZ023N04LSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ019N03LS Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ017NE2LS5IATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 27A 8SON</p>
 <p>BSZ018NE2LSI Infineon Technologies BSZ018NE2LSI Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ019N03L INFINEON BSZ019N03L INFINEON</p>	 <p>BSZ018NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 23A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ019N03LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 22A TSDSON-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ018NE2LSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ018NE2LSIATMA1 Datenblatt	BSZ018NE2LSIATMA1-Datenblätter	BSZ018NE2LSIATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ018NE2LSIATMA1
BSZ018NE2LSIATMA1 Electronic	BSZ018NE2LSIATMA1-Komponenten	BSZ018NE2LSIATMA1-Verteiler	BSZ018NE2LSIATMA1-Bild	BSZ018NE2LSIATMA1-Teil
BSZ018NE2LSIATMA1 Preis	BSZ018NE2LSIATMA1 Hersteller	BSZ018NE2LSIATMA1 Bild	BSZ018NE2LSIATMA1 Aktie	BSZ018NE2LSIATMA1 Inventar
BSZ018NE2LSIATMA1 Neu	BSZ018NE2LSIATMA1 Original	BSZ018NE2LSIATMA1 garantiert	BSZ018NE2LSIATMA1 RFQ	BSZ018NE2LSIATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited